

令和元年
電子デバイス・半導体電力変換合同研究会

学生奨励賞
滕飛 殿

論文発表

6.5kV耐圧SiC-MOSFETの
デバイスモデル開発

令和元年 電子デバイス・半導体電力変換
合同研究会における標記の功績を顕彰す
るため、学生奨励賞を贈呈致します

令和元年11月29日

一般社団法人 電気学会
パワーデバイス・パワーIC高性能化技術調査専門委員会
技術調査専門委員会 委員長 齋藤渉